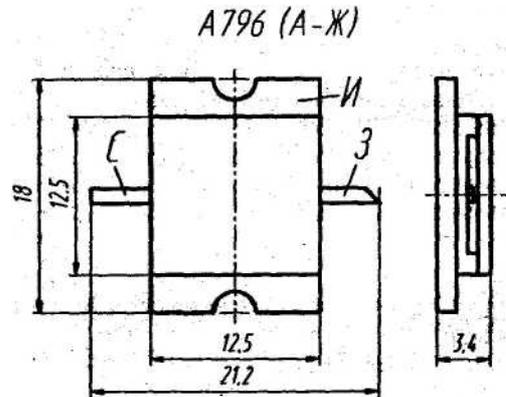


А796А, А796Б, А796В, А796Г, А796Д, А796Е, А796Ж

Транзисторы полевые арсенидогаллиевые пленарные с затвором в виде барьера Шотки и каналом n-типа генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, генераторах. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на кристаллодержателе.

Масса транзистора не более 5 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Выходная мощность при $Z_{вх} = Z_{вых} = 50 \text{ Ом}$, $T_k = 25^\circ\text{C}$, не менее:

А796А, $f = 7,9; 8,15; 8,4 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 8 \text{ В}$, $P_{ax} = 1,4 \text{ Вт}$	4 Вт
А796Б, $f = 5,9; 6,15; 6,4 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 8 \text{ В}$, $P_{ax} = 1 \text{ Вт}$	4 Вт
А796В, $f = 3,7; 3,95; 4,2 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 8 \text{ В}$, $P_{ax} = 1 \text{ Вт}$	5 Вт
А796Г, $f = 3,7; 3,95; 4,2 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 8 \text{ В}$, $P_{ax} = 1 \text{ Вт}$	5 Вт
А796Д, $f = 3,7; 3,95; 4,2 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 7 \text{ В}$, $P_{вх} = 0,6 \text{ Вт}$	2 Вт
А796Е, $f = 4,3; 4,55; 4,8 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 7 \text{ В}$, $P_{ax} = 0,6 \text{ Вт}$	2 Вт
А796Ж, $f = 8 \text{ ГГц}$, $U_{Cnum} = 8 \text{ В}$, $P_{ax} = 2 \text{ Вт}$	5 Вт

Коэффициент усиления по мощности,

А796А, А796Ж.....	4дБ
А796Б.....	6 дБ
А796В.....	7 дБ
А796Г, А796Д, А796Е.....	5 дБ

Коэффициент полезного действия стока, не менее 30%

Ток утечки затвора при $U_{зи} = -5 \text{ В}$, не более:

А796А, А796Б, А796В, А796Г, А796Ж.....	0,5 мА
А796Д, А796Е.....	0,25 мА

¹ Для А796Б гарантируются установленные значения электрических параметров в диапазоне частот 5,7...6,3 ГГц при подстройке внешними согласующими цепями при КСВ < 2.

² При измерении $P_{вых}$, K_u , ρ , η транзисторов А796Ж $Z_{вх}$ и $Z_{вых}$ не нормируются.

³ Режимы измерения K_u , ρ , η такие же, как и режимы измерения $P_{вых}$.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания стока.....	8 В
Постоянное напряжение затвор—исток.....	-5 В
Потенциал статического электричества.....	30 В
Постоянная рассеиваемая мощность и средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме ¹ при $T_k = 60...+35^\circ\text{C}$:	
А796А, А796Б, А796В, А796Г, А796Ж.....	14 Вт
А796Д, А796Е.....	7 Вт
Температура канала.....	+170 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	
А796А, А796Б, А796В, А796Г, А796Ж.....	9,5 °С/Вт
А796Д, А796Е.....	18 °С/Вт
Температура окружающей среды.....	-60... $T_k = +85^\circ\text{C}$

¹ При $T_k > +35^\circ\text{C}$ максимально допустимые рассеиваемые мощности рассчитываются по формуле

$$P_{\text{макс}} = P_{\text{ср.макс}} = (170 - T_k) / R_{\text{Т(П-К)}}, \text{ Вт.}$$

Не допускается касание вывода затвора незаземленным инструментом.

Минимально допустимое расстояние от кристаллодержателя до места пайки вывода 2 мм, температура пайки не выше +260 °С, время пайки не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от кристаллодержателя при температуре пайки не выше +150 °С в течение не более 3 с. При этом следует пользоваться серебряно-индиевыми припоями и другими, не приводящими к возникновению интерметаллических соединений. Допускается приварка к выводам на расстоянии не менее 0,5 мм от кристаллодержателя. Допускается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

При эксплуатации транзисторов следует принимать меры по устранению возможности самовозбуждения транзисторов.

Для А796А, А796В, А796Г, А796Д, А796Е допускается эксплуатация вне номинальной полосы рабочих частот (в пределах 20%) с дополнительным согласованием транзисторов с источником входного сигнала и нагрузки, при этом параметры не гарантируются.